シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ（PCT方式）
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

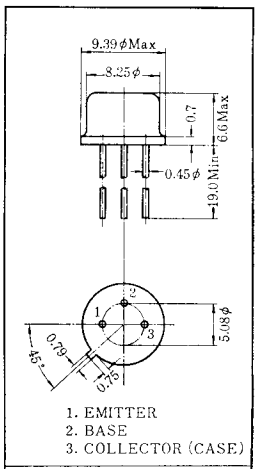
2SA497, 2SA498

○中電力増幅用

○ Medium Power Amplifier Applications.

- 高耐圧です　$V_{CEO}=-80V$ 2SA497
  $V_{CEO}=-50V$ 2SA498
- 飽和電圧が低い　$V_{CE}(sat)=-0.12V$(Typ.)
- 2SC497, 2SC498 とコンプリメンタリになります.
- Complementary to 2SC497 and 2SC498

Unit in mm



JEDEC	TO-39
EIAJ	TC-5, TB-5B
TOSHIBA	2-8J

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic		Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SA497	V_{CBO}	−80	V
	2SA498		−50	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA497	V_{CEO}	−80	V
	2SA498		−50	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流		I_C	−800	mA
エミッタ電流		I_E	800	mA
コレクタ損失		P_C	600	mW
接合温度		T_j	150	°C
保存温度		T_{stg}	−65～150	°C

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic		Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=-30V$, $I_E=0$	—	—	1.0	μA
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	$V_{EB}=-5V$, $I_C=0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SA497	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10mA$, $I_B=0$	−80	—	—	V
	2SA498			−50	—	—	
エミッタ・ベース間電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1mA$, $I_C=0$	−5	—	—	V
直流電流増幅率		(NOTE) $h_{FE}(1)$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-200mA$	40	—	240	
		$h_{FE}(2)$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-800mA$	13	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE}(sat)$	$I_C=-200mA$, $I_B=-20mA$	—	−0.12	−0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		$V_{BE}(sat)$	$I_C=-200mA$, $I_B=-20mA$	—	−0.9	−1.2	V
トランジション周波数		f_T	$V_{CE}=-10V$, $I_E=10mA$	—	70	—	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0$, f=1MHz	—	33	—	pF

Note : h_{FE} (1)により下表のように分類し，現品表示してあります.
According to the value of $h_{FE}(1)$, the 2SA497 and 2SA498 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA497—R 2SA498—R	40	80
2SA497—O 2SA498—O	70	140
2SA497—Y 2SA498—Y	120	240